
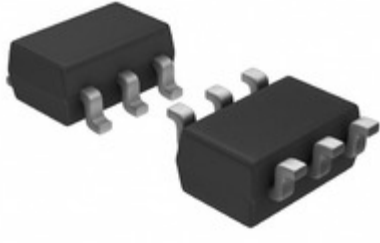
	<p>SI3457DV</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3457DV</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 4A SSOT-6</p> <p>Datenblätter:  SI3457DV.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37408 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3457DV
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 4A SSOT-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37408 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 4A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.1nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3457DV-ND

SI3457DV ist neu im Original, Suche SI3457DV Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3457DV AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3457DV: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3457CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3457DV-T1-E3 VIS SI3457DV-T1-E3 VIS</p>	 <p>SI3457DV Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 4A SSOT-6</p>	 <p>SI3457DV-T1 VISHAY SI3457DV-T1 VISHAY</p>
 <p>SI3457CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3457CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3457DV-T1-GE3 V SI3457DV-T1-GE3 V</p>	 <p>SI3457CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  SI3456BDV-T1-GE3 |  SI3456CDV-T1-E3 |  SI3456CDV-T1-E3 |  SI3456CDV-T1-GE3 |  SI3456CDV-T1-GE3 |
|  SI3456DDV-T1-E3 |  SI3456DDV-T1-E3 |  SI3456DDV-T1-GE3 |  SI3456DDV-T1-GE3 |  SI3456DV |
|  SI3456DV-NL |  SI3456DV-T1 |  SI3456DV-T1-E3 |  SI3456DV-T1-GE3 |  SI3457-B02-IT |
|  SI3457BDV |  SI3457BDV-T1 |  SI3457BDV-T1-E3 |  SI3457BDV-T1-E3 |  SI3457BDV-T1-GE3 |
|  SI3457BDV-T1-GE3 |  SI3457CDV-T1-E3 |  SI3457CDV-T1-E3 |  SI3457CDV-T1-GE3 |  SI3457CDV-T1-GE3 |
|  SI3457DV |  SI3457DV-T1 |  SI3457DV-T1-E3 |  SI3457DV-T1-GE3 |  SI3457DV-T1-E3 |
|  SI3458BDV-T1-E3 |  SI3458BDV-T1-E3 |  SI3458BDV-T1-GE3 |  SI3458BDV-T1-GE3 |  SI3458DV-T1-E3 |
|  SI3458DV-T1-E3 |  SI3458DV-T1-GE3 |  SI3459BDV-T1-E |  SI3459BDV-T1-E3 |  SI3459BDV-T1-E3 |
|  SI3459BDV-T1-GE3 |  SI3459BDV-T1-GE3 |  SI3459DV-T1-E3 |  SI3459DV-T1-E3 |  SI3459DV-T1-GE3 |
|  SI3460-E02-GMR |  SI3460-E03-GMR |  SI3460BDV-T1-E3 |  SI3460BDV-T1-E3 |  SI3460BDV-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

